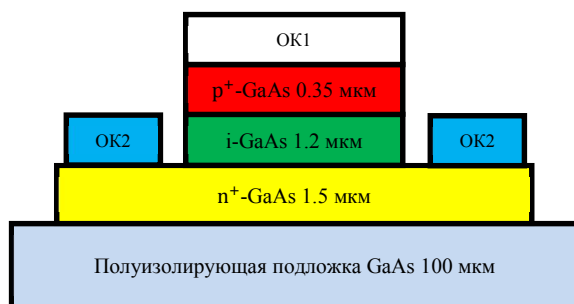




## Процесс PIN12

### Технология изготовления СВЧ МИС на основе GaAs pin-диодов

Сечение pin-диода



Технология изготовления СВЧ МИС на основе GaAs pin-диодов (процесс PIN12) подходит для разработки коммутационных схем и схем ограничителей мощности, работающих на частотах до 40 ГГц и выше. Технология позволяет формировать pin-диоды, тонкопленочные резисторы, МДМ-конденсаторы, спиральные катушки индуктивности и сквозные металлизированные отверстия. Технология доступна в режиме foundry.

Параметры процесса PIN12

Элемент	Параметр	Ед. изм.	Значение
Диоды	Диаметр	мкм	16, 20, 22, 28
	Пробивное напряжение	В	30
МДМ-конденсаторы	Удельная емкость	пФ/мм <sup>2</sup>	750
	Пробивное напряжение	В	70
WSi-резисторы	Слоевое сопротивление	Ом/кв	20, 50
Подложка	Толщина	мкм	100

С использованием процесса PIN12 были разработаны МИС ML307, MSM205, MSM207, MSW202.

По вопросам заказа и уточнения параметров обращаться по e-mail: [mmic@niipp.ru](mailto:mmic@niipp.ru) или по тел. (3822) 28-82-48.

С номенклатурой МИС СВЧ можно ознакомиться по ссылке <http://www.niipp.ru/catalog/> в разделе «Монолитные интегральные схемы СВЧ».